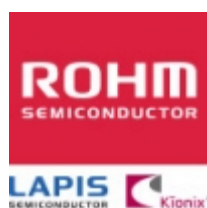


specificazioni	
Numero di parte	RQ5E030AJTCL
fabbricante	LAPIS Semiconductor
Descrizione	NCH 30V 3A MIDDLE POWER MOSFET
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	9206 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	1.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±12V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TSMT3
Serie	-
Rds On (max) a Id, Vgs	75 mOhm @ 3A, 4.5V
Dissipazione di potenza (max)	1W (Tc)
imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	SC-96
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 15V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	2.1nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V
Tensione drain-source (Vdss)	30V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	3A (Tc)

 RQ5E025ATTCL Rohm Semiconductor PCH -30V -2.5A MIDDLE POWER MOSF	 RQ5E025SN ROHM RQ5E025SN ROHM	 RQ5E025SP ROHM RQ5E025SP ROHM	 RQ5E030RP ROHM RQ5E030RP ROHM
 RQ5E035ATTCL Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3.5A TSMT	 RQ5E035BN ROHM RQ5E035BN ROHM	 RQ5E035AT MOS ROHM ROHM SOT-23	 RQ5E025TN ROHM RQ5E025TN ROHM

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited